

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第4区分
 【発行日】平成27年4月16日(2015.4.16)

【公開番号】特開2012-198977(P2012-198977A)
 【公開日】平成24年10月18日(2012.10.18)
 【年通号数】公開・登録公報2012-042
 【出願番号】特願2012-49108(P2012-49108)
 【国際特許分類】

G 1 1 C 11/405 (2006.01)
 G 1 1 C 11/56 (2006.01)
 H 0 1 L 21/8247 (2006.01)
 H 0 1 L 27/115 (2006.01)
 H 0 1 L 21/336 (2006.01)
 H 0 1 L 29/788 (2006.01)
 H 0 1 L 29/792 (2006.01)
 H 0 1 L 21/8242 (2006.01)
 H 0 1 L 27/108 (2006.01)
 H 0 1 L 27/105 (2006.01)
 H 0 1 L 27/10 (2006.01)
 H 0 1 L 29/786 (2006.01)
 C 2 3 C 14/08 (2006.01)

【 F I 】

G 1 1 C 11/34 3 5 2 B
 G 1 1 C 11/34 3 8 1 D
 G 1 1 C 11/34 3 8 1 A
 H 0 1 L 27/10 4 3 4
 H 0 1 L 29/78 3 7 1
 H 0 1 L 27/10 3 2 1
 H 0 1 L 27/10 4 4 1
 H 0 1 L 27/10 4 8 1
 H 0 1 L 29/78 6 1 3 B
 H 0 1 L 29/78 6 1 8 B
 C 2 3 C 14/08 K

【手続補正書】
 【提出日】平成27年2月25日(2015.2.25)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】発明の名称
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【発明の名称】半導体装置
 【手続補正2】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】

メモリセルと、
電位生成回路と、
データバッファと、
書き込み回路と、
読み出し回路と、
ベリファイ回路と、を有し、
前記電位生成回路は、第 1 の電位と、第 2 の電位とを生成する機能を有し、
前記データバッファは、第 1 のデータを保持する機能を有し、
前記書き込み回路は、前記第 1 の電位を前記メモリセルに供給し、第 2 のデータを前記メモリセルに書き込む機能を有し、
前記読み出し回路は、前記メモリセルの前記第 2 のデータを読み出す機能を有し、
前記ベリファイ回路は、前記読み出し回路により読み出された前記第 2 のデータが、前記データバッファにより保持された前記第 1 のデータと一致するか否かをベリファイする機能を有し、
前記読み出し回路により読み出された前記第 2 のデータと、前記データバッファにより保持された前記第 1 のデータとが一致しない場合、前記書き込み回路は、前記メモリセルに第 3 のデータを書き込み、前記メモリセルに前記第 2 の電位を供給する機能を有する半導体装置。